

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Eiji OKABE et al.

Serial No. NEW

: **Attn: APPLICATION BRANCH**

Filed December 4, 2003

: Attorney Docket No. 2003-1637A

LIQUID CRYSTAL COMPOSITION AND  
LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

**CLAIM OF PRIORITY UNDER 35 USC 119**

Commissioner for Patents

P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

THE COMMISSIONER IS AUTHORIZED  
TO CHARGE ANY DEFICIENCY IN THE  
FEE FOR THIS PAPER TO DEPOSIT  
ACCOUNT NO. 23-0975.

Sir:

Applicants in the above-entitled application hereby claim the date of priority under the International Convention of Japanese Patent Application No. 2002-352263, filed December 4, 2002, as acknowledged in the Declaration of this application.

A certified copy of said Japanese Patent Application is submitted herewith.

Respectfully submitted,

Eiji OKABE et al.

By:

  
Michael R. Davis

Registration No. 25,134  
Attorney for Applicants

MRD/pth  
Washington, D.C. 20006-1021  
Telephone (202) 721-8200  
Facsimile (202) 721-8250  
December 4, 2003

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年12月 4日

出願番号

Application Number:

特願2002-352263

[ ST.10/C ]:

[ JP2002-352263 ]

出願人

Applicant(s):

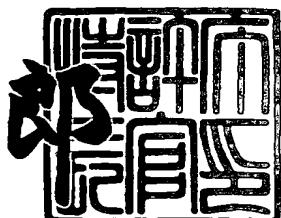
チッソ株式会社

チッソ石油化学株式会社

2003年 5月23日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田 信一



出証番号 出証特2003-3038176

【書類名】 特許願  
 【整理番号】 770024  
 【提出日】 平成14年12月 4日  
 【あて先】 特許庁長官殿  
 【国際特許分類】 C09K 19/04  
 G02F 1/13

## 【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市五井海岸5番地の1 チッソ石油化学株式会社 機能材料研究所内

【氏名】 岡部 英二

## 【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市五井海岸5番地の1 チッソ石油化学株式会社 機能材料研究所内

【氏名】 富 嘉剛

## 【特許出願人】

【識別番号】 000002071

【氏名又は名称】 チッソ株式会社

【代表者】 後藤 舜吉

【電話番号】 03-3534-9826

## 【特許出願人】

【識別番号】 596032100

【氏名又は名称】 チッソ石油化学株式会社

【代表者】 ▲かせ▼野 修平

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012276

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

特2002-352263

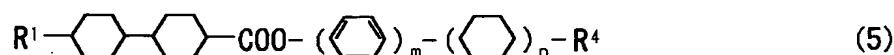
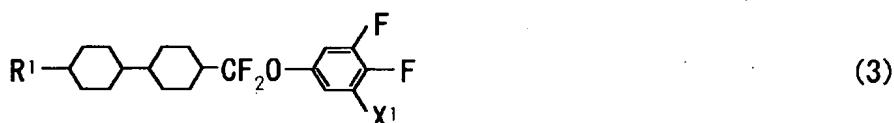
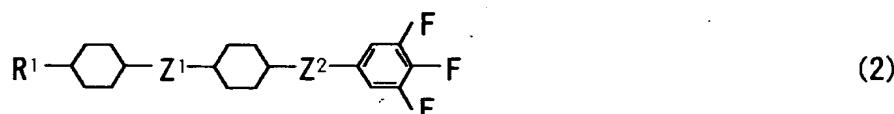
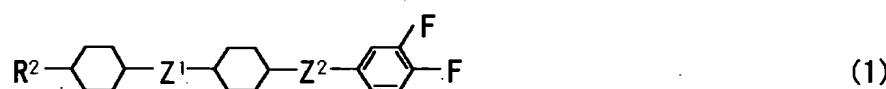
【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶組成物および液晶表示素子

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(1)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、式(2)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、式(3)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、式(4)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、および式(5)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を含有する液晶組成物。



式(1)、(2)、(3)、(4)、および(5)において、 $\text{R}^1$ はアルキルであり； $\text{R}^2$ はアルキルまたはアルケニルであり； $\text{R}^3$ はアルキル、アルコキシ、任意の水素がフッ素に置き換えられてもよいアルケニル、または $-\text{CF}_3$ であり； $\text{R}^4$ はアルキルまたはフッ素であり； $\text{X}^1$ は水素またはフッ素であり； $\text{Z}^1$ および $\text{Z}^2$ は独立して単結合または $-(\text{CH}_2)_2-$ であり； $m$ および $n$ は独立して0または1であり、そして $m$ と $n$ の和は1または2である。

【請求項2】 液晶組成物の全重量に基づいて、式(1)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を3～40重量%の範囲で、式(

2) で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を5~60重量%の範囲で、式(3)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を5~50重量%の範囲で、式(4)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を5~40重量%の範囲で、および式(5)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を3~30重量%の範囲で含有する請求項1に記載の液晶組成物。

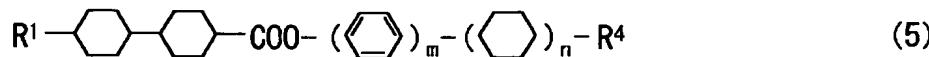
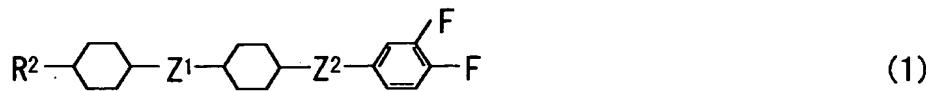
【請求項3】 式(6)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物をさらに含有する請求項1または2に記載の液晶組成物。



式(6)において、 $\text{R}^1$ はアルキルであり、 $\text{Z}^3$ は単結合または $-\text{CF}_2\text{O}-$ である。

【請求項4】 液晶組成物の全重量に基づいて、式(6)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を3~20重量%の範囲で含有する請求項3に記載の液晶組成物。

【請求項5】 第一成分として式(1)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、第二成分として式(7)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、並びに第三成分として式(4)および式(5)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を含有する液晶組成物。



式(1)、(7)、(4)、および(5)において、 $\text{R}^1$ はアルキルであり； $\text{R}^2$ はアルキルまたはアルケニルであり； $\text{R}^3$ はアルキル、アルコキシ、任意の水素がフッ素に置き換えられてもよいアルケニル、または $-\text{CF}_3$ であり； $\text{R}^4$ はアルキルまたはフッ素であり； $\text{X}^1$ は水素またはフッ素であり； $\text{Y}^1$ はフッ素または $-\text{OCF}_3$ であり； $\text{Z}^1$ および $\text{Z}^2$ は独立して単結合または $-(\text{CH}_2)_2-$ であり； $m$ および $n$ は独立して0または1であり、そして $m$ と $n$ の和は1または2である。

**【請求項6】** 第三成分が式(4)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物である請求項5に記載の液晶組成物。

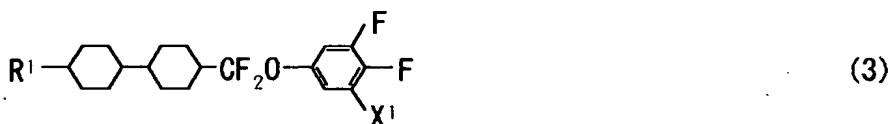
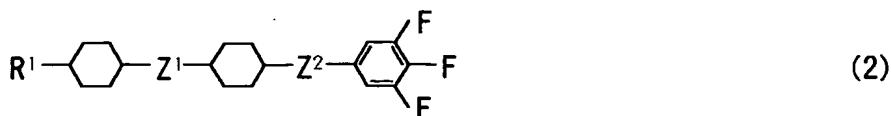
**【請求項7】** 第三成分が式(5)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物である請求項5に記載の液晶組成物。

**【請求項8】** 第三成分が式(4)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、および式(5)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物である請求項5に記載の液晶組成物。

**【請求項9】** 液晶組成物の全重量に基づいて、第一成分を5～60重量%の範囲で、第二成分を5～40重量%の範囲で、および第三成分を5～60重量%の範囲で含有する請求項5から8のいずれか1項に記載の液晶組成物。

**【請求項10】** 第四成分として式(2)、(3)および(6)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物をさらに含有する請求項5

から9のいずれか1項に記載の液晶組成物。



式(2)、(3)および(6)において、 $\text{R}^1$ はアルキルであり； $\text{X}^1$ は水素またはフッ素であり； $\text{Z}^1$ および $\text{Z}^2$ は独立して単結合または $-(\text{CH}_2)_2-$ であり； $\text{Z}^3$ は単結合または $-\text{CF}_2\text{O}-$ である。

**【請求項11】** 液晶組成物の全重量に基づいて、第四成分を10～50重量%の範囲で含有する請求項10に記載の液晶組成物。

**【請求項12】** 請求項1から11のいずれか1項に記載の液晶組成物を含有する液晶表示素子。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

##### 【発明の属する技術分野】

本発明は、主としてAM(active matrix)素子に適する液晶組成物およびこの組成物を含有するAM素子に関する。

##### 【0002】

##### 【従来の技術】

液晶表示素子において、液晶の動作モードに基づいた分類は、PC(phase change)、TN(twisted nematic)、STN(super twisted nematic)、ECB(electrically controlled birefringence)、OCB(optically compensated bend)、IPS(in-plane switching)、VA(vertical alignment)などである。素子の駆動方式に基づいた分類は、PM(passive matrix)とAM(active matrix)である。PMはスタティック(static)とマルチプレックス(multiplex)などに分類され、AMはTFT(thin film transistor)、MIM(meta

insulator metal) などに分類される。TFTの分類は非晶質シリコン (amorphous silicon) および多結晶シリコン (polycrystal silicon) である。後者は製造工程によって高温型と低温型とに分類される。光源に基づいた分類は、自然光を利用する反射型、バックライトを利用する透過型、そして自然光とバックライトの両方を利用する半透過型である。

## 【0003】

これらの素子は適切な特性を有する液晶組成物を含有する。良好な一般的特性を有するAM素子を得るには組成物の一般的特性を向上させる。2つの一般的特性における関連を下記の表1にまとめた。組成物の一般的特性を市販されているAM素子に基づいてさらに説明する。ネマチック相の温度範囲は、素子の使用できる温度範囲に関連する。ネマチック相の好ましい上限温度は70°C以上であり、そしてネマチック相の好ましい下限温度は-20°C以下である。組成物の粘度は素子の応答時間に関連する。素子で動画を表示するためには短い応答時間が好ましい。したがって、組成物における小さな粘度が好ましい。低い温度における小さな粘度はより好ましい。

## 【0004】

表1 組成物とAM素子における一般的特性

No.	組成物の一般的特性	AM素子の一般的特性
1	ネマチック相の温度範囲が広い	使用できる温度範囲が広い
2	粘度が小さい <sup>1)</sup>	応答時間が短い
3	光学異方性が適切である	コントラスト比が大きい
4	しきい値電圧が低い	消費電力が小さい、コントラスト比が大きい
5	比抵抗が大きい	電圧保持率が大きい、コントラスト比が大きい

1) 液晶セルに組成物を注入する時間が短縮できる

## 【0005】

組成物の光学異方性は、素子のコントラスト比に関連する。素子におけるコントラスト比を最大にするために、透過型のAM素子では組成物の光学異方性 ( $\Delta n$ ) と素子のセルギャップ (d) との積 ( $\Delta n \cdot d$ ) を約0.45 μmに設計する。したがって、組成物における光学異方性は主に0.08~0.12の範囲である。一方、反射型および半透過型のAM素子における $\Delta n \cdot d$ は約0.25 μ

mである。反射型および半透過型のAM素子におけるセルギャップは、応答時間と製造技術とを考慮して2.0~4.0 μmである。したがって、組成物における光学異方性は主に0.06~0.075の範囲である。組成物における低いしきい値電圧は素子における小さな消費電力と大きなコントラスト比に寄与する。したがって、低いしきい値電圧が好ましい。組成物における大きな比抵抗は、素子における大きな電圧保持率と大きなコントラスト比に寄与する。したがって、初期に大きな比抵抗を有する組成物が好ましい。長時間使用したあとでも大きな比抵抗を有する組成物が好ましい。

## 【0006】

反射型または半透過型のAM素子において、小さな消費電力で駆動し、大きなコントラスト比で表示するために、小さな光学異方性、低いしきい値電圧および大きな比抵抗を有する組成物が特に望まれている。従来の組成物は、次の特許文献に開示されている。

## 【0007】

## 【特許文献1】

特開平10-204016号公報

## 【特許文献2】

特開平10-204436号公報

## 【特許文献3】

特開2001-288470号公報

## 【0008】

## 【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、ネマチック相の広い温度範囲、小さな粘度、小さな光学異方性、低いしきい値電圧、および大きな比抵抗などの特性において、複数の特性を充足する液晶組成物を提供することにある。この目的は複数の特性に関して適切なバランスを有する液晶組成物を提供することでもある。この目的は、この組成物を含有し、そして特に大きな電圧保持率を有する液晶表示素子を提供することでもある。

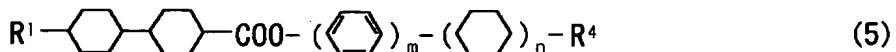
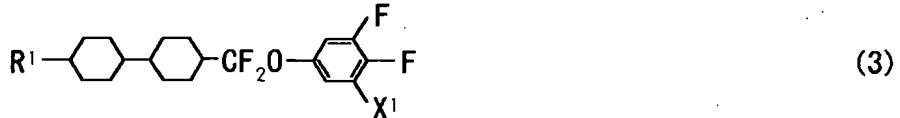
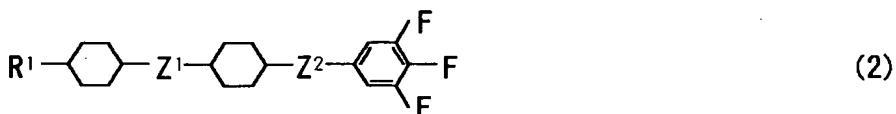
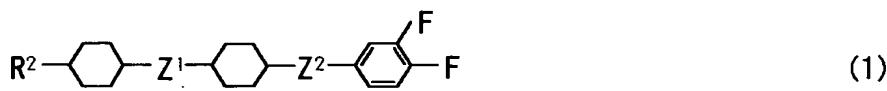
## 【0009】

## 【課題を解決するための手段】

本発明は下記の項1から15のとおりである。

1. 式(1)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、式(2)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、式(3)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、式(4)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、および式(5)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を含有する液晶組成物。

## 【0010】



## 【0011】

式(1)、(2)、(3)、(4)、および(5)において、 $\text{R}^1$ はアルキルであり； $\text{R}^2$ はアルキルまたはアルケニルであり； $\text{R}^3$ はアルキル、アルコキシ、任意の水素がフッ素に置き換えられてもよいアルケニル、または $-\text{CF}_3$ であり； $\text{R}^4$ はアルキルまたはフッ素であり； $\text{X}^1$ は水素またはフッ素であり； $\text{Z}^1$ および $\text{Z}^2$ は独立して単結合または $-(\text{CH}_2)_2-$ であり； $m$ および $n$ は独立して0または1であり、そして $m$ と $n$ の和は1または2である。

## 【0012】

2. 液晶組成物の全重量に基づいて、式（1）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を3～40重量%の範囲で、式（2）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を5～60重量%の範囲で、式（3）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を5～50重量%の範囲で、式（4）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を5～40重量%の範囲で、および式（5）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を3～30重量%の範囲で含有する項1に記載の液晶組成物。

## 【0013】

3. 式（6）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物をさらに含有する項1または2に記載の液晶組成物。



式（6）において、 $\text{R}^1$ はアルキルであり、 $\text{Z}^3$ は単結合または $-\text{CF}_2\text{O}-$ である。

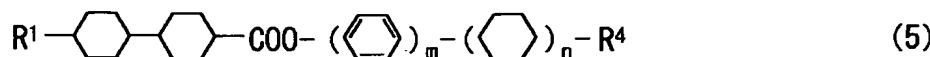
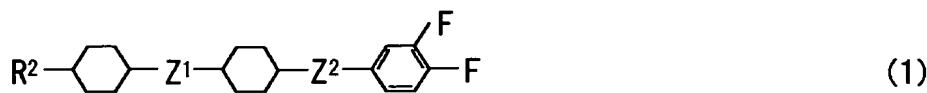
## 【0014】

4. 液晶組成物の全重量に基づいて、式（6）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を3～20重量%の範囲で含有する項3に記載の液晶組成物。

## 【0015】

5. 第一成分として式（1）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、第二成分として式（7）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、並びに第三成分として式（4）および式（5）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を含有する液晶組成物。

【0016】



【0017】

式(1)、(7)、(4)、および(5)において、 $\text{R}^1$ はアルキルであり； $\text{R}^2$ はアルキルまたはアルケニルであり； $\text{R}^3$ はアルキル、アルコキシ、任意の水素がフッ素に置き換えられてもよいアルケニル、または $-\text{CF}_3$ であり； $\text{R}^4$ はアルキルまたはフッ素であり； $\text{X}^1$ は水素またはフッ素であり； $\text{Y}^1$ はフッ素または $-\text{OCF}_3$ であり； $\text{Z}^1$ および $\text{Z}^2$ は独立して単結合または $-\text{(CH}_2\text{)}_2-$ であり； $m$ および $n$ は独立して0または1であり、そして $m$ と $n$ の和は1または2である。

【0018】

6. 第三成分が式(4)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物である項5に記載の液晶組成物。

【0019】

7. 第三成分が式(5)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物である項5に記載の液晶組成物。

【0020】

8. 第三成分が式(4)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物、および式(5)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物である項5に記載の液晶組成物。

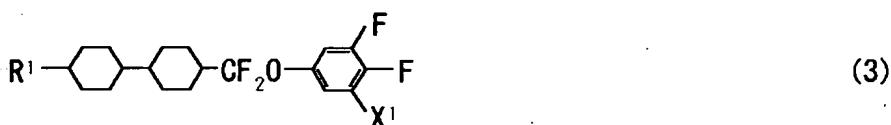
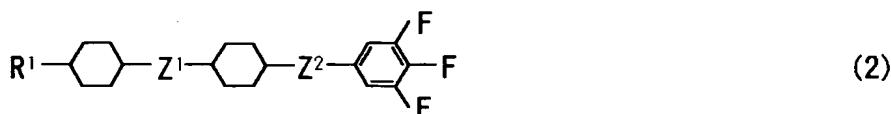
## 【0021】

9. 液晶組成物の全重量に基づいて、第一成分を5～60重量%の範囲で、第二成分を5～40重量%の範囲で、および第三成分を5～60重量%の範囲で含有する項5から8のいずれか1項に記載の液晶組成物。

## 【0022】

10. 第四成分として式(2)、(3)および(6)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物をさらに含有する項5から9のいずれか1項に記載の液晶組成物。

## 【0023】



## 【0024】

式(2)、(3)および(6)において、 $\text{R}^1$ はアルキルであり； $\text{X}^1$ は水素またはフッ素であり； $\text{Z}^1$ および $\text{Z}^2$ は独立して単結合または $-(\text{CH}_2)_2-$ であり； $\text{Z}^3$ は単結合または $-\text{CF}_2\text{O}-$ である。

## 【0025】

11. 液晶組成物の全重量に基づいて、第四成分を10～50重量%の範囲で含有する項10に記載の液晶組成物。

## 【0026】

12. 請求項1から11のいずれか1項に記載の液晶組成物を含有する液晶表示素子。

## 【0027】

13. 第四成分が式(2)で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物である項10に記載の液晶組成物。

## 【0028】

14. 第四成分が式（3）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物である項10に記載の液晶組成物。

## 【0029】

15. 第四成分が式（6）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物である項10に記載の液晶組成物。

## 【0030】

## 【発明の実施の形態】

この明細書における用語の使い方は次のとおりである。本発明の液晶組成物または本発明の液晶表示素子をそれぞれ「組成物」または「素子」と略すことがある。液晶表示素子は液晶表示パネルおよび液晶表示モジュールの総称である。液晶組成物の主成分は液晶性化合物である。この液晶性化合物は、ネマチック相、スマクチック相などの液晶相を有する化合物および液晶相を有さないが組成物の成分として有用な化合物の総称である。式（1）で表わされる化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を「化合物（1）」と略すことがある。他の式に関する化合物も同様に略すことがある。

## 【0031】

ネマチック相の上限温度を「上限温度」と略すことがある。ネマチック相の下限温度を「下限温度」と略すことがある。「比抵抗が大きい」は、組成物が初期に大きな比抵抗を有し、そして長時間使用したあとでも組成物が大きな比抵抗を有することを意味する。「電圧保持率が大きい」は、素子が初期に大きな電圧保持率を有し、そして長時間使用したあとでも素子が大きな電圧保持率を有することを意味する。光学異方性などの特性を説明するときは、実施例に記載した方法で測定した値を用いる。組成物における成分の割合（百分率）は、組成物の全重量に基づいた重量百分率（重量%）である。

## 【0032】

本発明の組成物は、ネマチック相の広い温度範囲、小さな粘度、小さな光学異方性、低いしきい値電圧、および大きな比抵抗などの特性において、複数の特性を充足する。この組成物は、複数の特性に関して適切なバランスを有する。この

組成物を含有する素子は、特に大きな電圧保持率を有する。

【0033】

本発明の組成物を次の順で説明する。第一に、組成物における成分の構成を説明する。第二に、成分である化合物の主要な特性、および化合物が組成物に及ぼす主要な効果を説明する。第三に、成分である化合物の好ましい割合およびその理由を説明する。第四に、成分である化合物の好ましい形態を説明する。第五に、成分である化合物の具体的な例を示す。第六に、成分である化合物の合成法を説明する。

【0034】

第一に、組成物における成分の構成を説明する。成分である化合物の組み合せは26とおりである。これをタイプ1～タイプ26に分類して表2にまとめた。表2においてマル印は該当する化合物が成分であることを意味する。空欄は該当する化合物が成分でないことを意味する。例えば、タイプ1は、化合物(1)、化合物(2)、化合物(3)、化合物(4)および化合物(5)が組成物の成分であることを意味する。

## 【0035】

表2 化合物の組み合わせ例

	化合物(1)	化合物(2)	化合物(3)	化合物(4)	化合物(5)	化合物(6)	化合物(7)
タイプ1	○	○	○	○	○		
タイプ2	○	○	○	○	○	○	
タイプ3	○			○			○
タイプ4	○	○		○			○
タイプ5	○		○	○			○
タイプ6	○			○		○	○
タイプ7	○	○	○	○			○
タイプ8	○	○		○		○	○
タイプ9	○		○	○		○	○
タイプ10	○	○	○	○		○	○
タイプ11	○				○		○
タイプ12	○	○			○		○
タイプ13	○		○		○		○
タイプ14	○				○	○	○
タイプ15	○	○	○		○		○
タイプ16	○	○			○	○	○
タイプ17	○		○		○	○	○
タイプ18	○	○	○		○	○	○
タイプ19	○			○	○		○
タイプ20	○	○		○	○		○
タイプ21	○		○	○	○		○
タイプ22	○			○	○	○	○
タイプ23	○	○	○	○	○		○
タイプ24	○	○		○	○	○	○
タイプ25	○		○	○	○	○	○
タイプ26	○	○	○	○	○	○	○

## 【0036】

本発明の組成物は組成物Aと組成物Bに分類される。組成物Aはその他の化合物をさらに含有してもよい。「その他の化合物」は液晶性化合物、添加物などである。その他の化合物は、化合物(1)～化合物(7)とは異なる。この液晶性化合物は、特性を調整する目的で組成物に混合される。この添加物は光学活性な化合物、色素などである。液晶のらせん構造を誘起してねじれ角を与える目的で光学活性な化合物が組成物に混合される。G H (Guest host) モードの素子に適合させるために色素が組成物に混合される。

## 【0037】

組成物Bは、実質的に化合物(1)～化合物(7)から選択された化合物のみからなる。「実質的に」は、これらの化合物とは異なる液晶性化合物を組成物Bが含有しないことを意味する。「実質的に」は、これらの化合物に含まれていた不純物、光学活性な化合物、色素などの化合物を組成物Bがさらに含有してもよ

いことも意味する。組成物Bは組成物Aに比較して成分の数が少ない。組成物Bはコストの観点から組成物Aよりも好ましい。その他の液晶性化合物を混合することによって物性をさらに調整できるので、組成物Aは組成物Bよりも好ましい。

## 【0038】

第二に、成分である化合物の主要な特性、および化合物が組成物に及ぼす主要な効果を説明する。化合物の主要な特性を表3にまとめた。表3の記号において、Lは大きいまたは高い、Mは中程度の、そしてSは小さいまたは低いを意味する。0は誘電率異方性がほぼゼロである（または極めて小さい）ことを意味する。L、MおよびSの記号は、これらの化合物における相対的な評価である。

## 【0039】

表3 化合物の特性

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
上限温度	M	M	M	S	L	M	S
粘度	M	L	M	S	S	M	M
光学異方性	M	M	M	S	M	M	M
誘電率異方性	S	M	L	0	0	M	L
比抵抗	L	L	L	L	L	L	L

## 【0040】

化合物を組成物に添加したとき、組成物に生じた主要な効果は次のとおりである。高い上限温度を有する化合物は組成物における上限温度を上げる。小さな粘度を有する化合物は組成物における粘度を下げる。小さな光学異方性を有する化合物は組成物における光学異方性を下げる。大きな光学異方性を有する化合物は組成物における光学異方性を上げる。大きな誘電率異方性を有する化合物は組成物における誘電率異方性を上げ、そしてしきい値電圧を下げる。大きな比抵抗を有する化合物は素子における電圧保持率を上げる。

## 【0041】

第三に、成分である化合物の好ましい割合およびその理由を説明する。まず、本発明の項1およびこの従属項における組成物は次のとおりである。これらの組成物は、表2におけるタイプ1およびタイプ2に相当する。これらの組成物において、化合物(1)の好ましい割合は、上限温度を上げるために3%以上であり、そして下限温度を下げるために40%以下である。さらに好ましい割合は3%

～25%である。化合物(2)の好ましい割合は、しきい値電圧を下げるために5%以上であり、そして下限温度を下げるために60%以下である。さらに好ましい割合は15%～55%である。

#### 【0042】

化合物(3)の好ましい割合は、しきい値電圧を特に下げるために5%以上であり、そして下限温度を下げるために50%以下である。さらに好ましい割合は10%～40%である。化合物(4)の好ましい割合は、光学異方性を下げるために5%以上であり、そして下限温度を下げるために40%以下である。さらに好ましい割合は10%～35%である。化合物(5)の好ましい割合は、光学異方性を下げるため、または上限温度を上げるために3%以上であり、そして下限温度を下げるために30%以下である。さらに好ましい割合は5%～15%である。化合物(6)をさらに混合する場合、この化合物における好ましい割合は、しきい値電圧を下げるために3%以上であり、そして下限温度を下げるために20%以下である。さらに好ましい割合は3%～10%である。

#### 【0043】

次に、本発明の項5およびこの従属項における組成物は次のとおりである。これらの組成物は、表2におけるタイプ3からタイプ26に相当する。これらの組成物において、第一成分の好ましい割合は、上限温度を上げるために5%以上であり、そして下限温度を下げるために60%以下である。さらに好ましい割合は20%～50%である。第二成分好ましい割合は、しきい値電圧を下げるために5%以上であり、そして下限温度を下げるために40%以下である。さらに好ましい割合は10%～30%である。第三成分の好ましい割合は、光学異方性を下げるために5%以上であり、そして下限温度を下げるために60%以下である。さらに好ましい割合は10%～50%である。第四成分をさらに混合する場合、この成分の好ましい割合は、しきい値電圧をさらに下げるために10%以上であり、そして下限温度をさらに下げるために50%以下である。さらに好ましい割合は20%～40%である。

#### 【0044】

第四に、成分である化合物の好ましい形態を説明する。成分である化合物の化

学式において、 $R^1$  の記号を複数の化合物に用いた。これらの化合物において、 $R^1$  の意味は同一であってもよいし、または異なってもよい。例えば、化合物(1)の $R^1$  がエチルであり、化合物(2)の $R^1$  がエチルであるケースがある。化合物(1)の $R^1$  がエチルであり、化合物(2)の $R^1$  がプロピルであるケースもある。このルールは、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $Z^1$ 、 $Z^2$ 、 $Z^3$ 、 $X^1$ 、 $Y^1$ 、 $m$ 、または $n$ の記号についても適用する。

## 【0045】

好ましい $R^1$  は炭素数1～10のアルキルである。好ましい $R^2$  は炭素数1～10のアルキルまたは炭素数2～10のアルケニルである。好ましい $R^3$  は炭素数1～10のアルキル、炭素数1～10のアルコキシ、炭素数2～10の任意の水素がフッ素に置き換えられてもよいアルケニル、または $-CF_3$  である。好ましい $R^4$  はフッ素または炭素数1～10のアルキルである。

## 【0046】

好ましいアルキルは、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチルまたはオクチルである。さらに好ましいアルキルは、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、またはヘプチルである。

## 【0047】

好ましいアルケニルは、ビニル、1-プロペニル、2-プロペニル、1-ブテン、2-ブテン、3-ブテン、1-ペンテニル、2-ペンテニル、3-ペンテニル、4-ペンテニル、1-ヘキセニル、2-ヘキセニル、3-ヘキセニル、4-ヘキセニル、または5-ヘキセニルである。さらに好ましいアルケニルは、ビニル、1-プロペニル、3-ブテン、または3-ペンテニルである。これらのアルケニルにおける $-CH=CH-$  の好ましい立体配置は、二重結合の位置に依存する。1-プロペニル、1-ブテン、1-ペンテニル、1-ヘキセニル、3-ペンテニル、3-ヘキセニルのようなアルケニルにおいてはトランスが好ましい。2-ブテン、2-ペンテニル、2-ヘキセニルのようなアルケニルにおいてはシスが好ましい。

## 【0048】

好ましいアルコキシは、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ、ペンチ

ルオキシ、ヘキシリオキシ、またはヘプチルオキシである。さらに好ましいアルコキシは、メトキシまたはエトキシである。

## 【0049】

任意の水素がフッ素で置き換えられたアルケニルの好ましい例は、2, 2-ジフルオロビニル、3, 3-ジフルオロ-2-プロペニル、4, 4-ジフルオロ-3-ブテニル、5, 5-ジフルオロ-4-ペンテニルである。さらに好ましい例は、2, 2-ジフルオロビニルおよび4, 4-ジフルオロ-3-ブテニルである。

## 【0050】

成分である化合物において、1, 4-シクロヘキシレンに関する立体配置は、シスよりもトランスが好ましい。

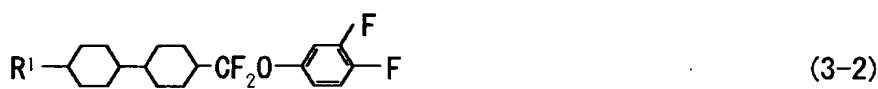
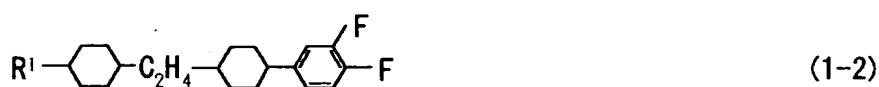
## 【0051】

第五に、成分である化合物の具体的な例を示す。好ましい化合物(1)～化合物(7)は、化合物(1-1)～化合物(7-3)である。これら的好ましい化合物において、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>およびR<sup>5</sup>の記号を複数の化合物に用いた。任意の2つの化合物において、R<sup>1</sup>などによって表わされる具体的な基は同一であってもよいし、または異なってもよい。このことはすでに記載した。

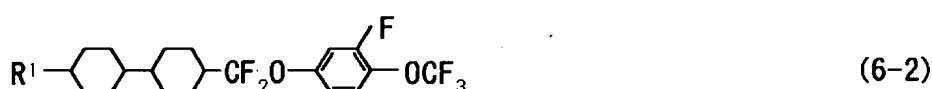
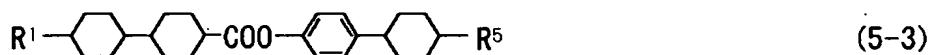
## 【0052】

R<sup>1</sup>およびR<sup>5</sup>は独立してアルキルであり、R<sup>2</sup>はアルキルまたはアルケニルである。好ましいR<sup>1</sup>またはR<sup>5</sup>は炭素数1～10のアルキルである。好ましいR<sup>2</sup>は、炭素数1～10のアルキルまたは炭素数2～10のアルケニルである。好ましいアルキルまたはアルケニル、およびさらに好ましいアルキルまたはアルケニルはすでに記載したとおりである。これらのアルケニルにおいて、-CH=CH-の好ましい立体配置は、すでに記載したとおりである。これらの好ましい化合物において1, 4-シクロヘキシレンに関する立体配置は、シスよりもトランスが好ましい。

【0053】



## 【0054】



## 【0055】

第六に、成分である化合物の合成法を説明する。これらの化合物は既知の方法によって合成できる。合成法を例示する。化合物（1-1）は、特開昭57-154135号公報に記載された方法によって合成する。化合物（2-1）は、特開平2-233626号公報に記載された方法によって合成する。化合物（3-1）、化合物（6-2）、化合物（7-1）は、特開平2-233626号公報に記載された方法を修飾することによって合成する。化合物（4-1）は、特開昭59-70624号公報に記載された方法によって合成する。化合物（5-1）は、特開昭56-135445号公報に記載された方法によって合成する。

## 【0056】

合成法を記載しなかった化合物は、オーガニック・シンセシス (Organic Syntheses, John Wiley & Sons, Inc)、オーガニック・リアクションズ (Organic Reactions, John Wiley & Sons, Inc)、コンプリヘンシブ・オーガニック・シンセシス (Comprehensive Organic Synthesis, Pergamon Press)、新実験化学講座 (丸善)などの成書に記載された方法によって合成できる。組成物は、このようにして得た化合物から公知の方法によって調製される。例えば、成分である化合物を混合し、加熱によって互いに溶解させる。

## 【0057】

本発明の組成物は主として0.06～0.075の光学異方性を有する。この組成物を含有する素子は大きな電圧保持率を有する。したがって、この組成物はAM素子に適する。この組成物は反射型または半透過型のAM素子に特に適する。

## 【0058】

この組成物はAM素子だけでなくPM素子にも使用することが可能である。この組成物は、PC、TN、STN、ECB、OCB、IPS、VAなどのモードを有する素子に使用できる。これらの素子が反射型、透過型または半透過型であってもよい。この組成物をマイクロカプセル化して作製したNCAp (nematic curvilinear aligned phase) 素子や、組成物中に三次元の網目状高分子を形成させたPD (polymer dispersed) 素子、例えばPN (polymer network) 素子にも使用できる。

## 【0059】

## 【実施例】

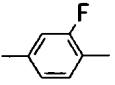
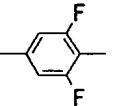
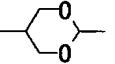
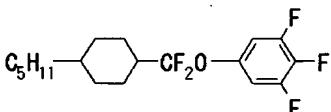
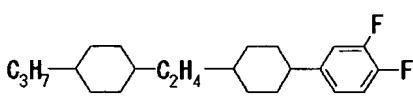
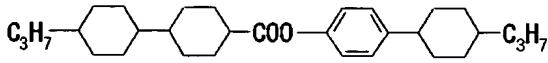
実施例により本発明を詳細に説明する。本発明は下記の実施例によって限定されない。比較例および実施例における化合物は、下記の表4の定義に基づいて記号により表した。表4において、1, 4-シクロヘキシレンおよび1, 3-ジオキサン-2, 5-ジイルに関する立体配置はトランスである。 $-CH=CH-$ の結合基に関する立体配置はトランスである。実施例において記号の後にあるかつてこの内の番号は好ましい化合物の番号に対応する。(-)の記号はその他の化合物

を意味する。化合物の割合（百分率）は、組成物の全重量に基づいた重量百分率（重量%）である。最後に、組成物の特性値をまとめた。

## 【0060】

表4 記号を用いた化合物の表記方法



1)左末端基 R-	記号	3)結合基 -Z <sub>n</sub> -	記号
C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> -	n-	-C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -	2
C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> OC <sub>m</sub> H <sub>2m</sub> -	nOm-	-COO-	E
CH <sub>2</sub> =CH-	V-	-CF <sub>2</sub> O-	X
CH <sub>2</sub> =CHC <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> -	Vn-		
C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> CH=CHC <sub>m</sub> H <sub>2m</sub> -	nVm-		
2)環構造 -A <sub>n</sub> -	記号	4)右末端基 -X	記号
	B	-F	-F
	B(F)	-Cl	-CL
	B(F, F)	-CF <sub>3</sub>	-CF3
	H	-OCF <sub>3</sub>	-OCF3
	G	-OCF <sub>2</sub> H	-OCF2H
		-C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub>	-n
		-OC <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub>	-On
		-CH=CH <sub>2</sub>	-V
		-CH=CF <sub>2</sub>	-VFF
		-COOCH <sub>3</sub>	-EMe
5)表記例			
例1 5-HXB(F, F)-F		例3 3-H2HB(F)-F	
			
例2 3-HHEBH-3			
			

## 【0061】

特性値の測定は次の方法にしたがった。

ネマチック相の上限温度 ( $N I$ ; °C) : 偏光顕微鏡を備えた融点測定装置のホットプレートに試料を置き、1°C/分の速度で加熱した。試料の一部がネマチック相から等方性液体に変化したときの温度を測定した。ネマチック相の上限温度を「上限温度」と略すことがある。

## 【0062】

ネマチック相の下限温度 ( $T_C$ ; °C) : ネマチック相を有する試料を0°C、-10°C、-20°C、-30°C、および-40°Cのフリーザー中に10日間保管したあと、液晶相を観察した。例えば、試料が-20°Cではネマチック相のままであり、-30°Cでは結晶またはスメクチック相に変化したとき、 $T_C$ を<-20°Cと記載した。ネマチック相の下限温度を「下限温度」と略すことがある。

## 【0063】

光学異方性 ( $\Delta n$ ; 25°Cで測定) : 波長が589 nmの光によりアッペ屈折計を用いて測定した。

## 【0064】

粘度 ( $\eta$ ; 25°Cで測定; mPa·s) : 粘度の測定にはE型粘度計を用いた

## 【0065】

誘電率異方性 ( $\Delta \epsilon$ ; 25°Cで測定) : 2枚のガラス基板の間隔(セルギャップ)が9 μm、ツイスト角が80度のTN素子に試料を入れた。このセルに10ボルトを印加して、液晶分子の長軸方向における誘電率 ( $\epsilon \parallel$ ) を測定した。0.5ボルトを印加して、液晶分子の短軸方向における誘電率 ( $\epsilon \perp$ ) を測定した。誘電率異方性の値は、 $\Delta \epsilon = \epsilon \parallel - \epsilon \perp$  の式から計算した。正の誘電率異方性を有する組成物をこの方法によって測定した。試料が化合物のときは、化合物を適切な液晶組成物に混合して誘電率異方性を測定した。

## 【0066】

しきい値電圧 ( $V_{th}$ ; 25°Cで測定; V) : 2枚のガラス基板の間隔(セルギャップ)が( $0.5/\Delta n$ ) μmであり、ツイスト角が80度であるノーマリ

ホワイトモード (normally white mode) のTN素子に試料を入れた。 $\Delta n$ は上記の方法で測定した光学異方性の値である。このTN素子に周波数が32Hzである矩形波を印加した。印加電圧を上昇させ、素子を通過する光の透過率が90%になったときの電圧の値を測定した。

## 【0067】

電圧保持率 (VHR ; %) : 日本電子機械工業会規格 (Standard of Electric Industries Association of Japan) EIAJ・ED-2521Aに記載された液晶組成物および配向膜を有する素子の電圧保持率を測定する方法にしたがった。測定に用いたTN素子はポリイミド配向膜を有し、そしてセルギャップは6μmであった。25°CのTN素子に印加した電圧の波形を陰極線オシロスコープで観測し、単位周期において電圧曲線と横軸との間の面積を求めた。TN素子を取り除いたあと測定した電圧の波形から同様にして面積を求めた。2つの面積の値を比較して電圧保持率を算出した。この測定値をVHR-1で表した。次に、このTN素子を100°C、250時間加熱した。25°Cに戻したあと、同様な方法で電圧保持率を測定した。加熱後の測定値をVHR-2で表した。この加熱テストは、素子を長時間使用するテストの代わりに行った。

## 【0068】

## 比較例1

特開2001-288470号公報に開示された組成物の中から実施例8を選んだ。理由は、この組成物が本発明の化合物(3)を含有し、そして最も小さな光学異方性を有するからである。この組成物の成分および特性は下記のとおりである。この組成物において、下限温度は高く、しきい値電圧は高く、そしてVHR-2は小さい。

3 - H E H - 3	8 %
4 - H E H - 3	8 %
3 - H H E H - 3	4 %
4 - H H E H - 3	4 %
5 - H H E H - 3	4 %
3 - G H B (F, F) - F	5 %

4 - H H E B (F, F) - F	4 %
3 - H H X B (F, F) - F	3 %
3 - H H - 4	5 %
3 - H H - O 1	7 %
5 - H H - O 1	10 %
1 V 2 - H H - 3	10 %
2 - H H - E M e	8 %
3 - H H - E M e	5 %
3 - H B - O 2	5 %
3 - H H B - 1	4 %
3 - H H B - O 1	3 %
4 - H B B H - 4	3 %

N I = 82. 4°C ; T<sub>C</sub> < -20°C ; Δn = 0. 053 ; η = 14. 6 MPa  
 s ; V t h = 2. 47V ; V H R - 1 = 99. 0 % ; V H R - 2 = 83. 2 %

## 【0069】

## 比較例2

特開2001-288470号公報に開示された組成物の中から実施例18を選んだ。理由は、この組成物が本発明の化合物(3)を含有し、そして最も低いしきい値電圧を有するからである。この組成物の成分および特性は下記のとおりである。この組成物において、上限温度は低く、下限温度は高く、そしてV H R - 2 は小さい。

3 - H H E H - 3	4 %
4 - H H E H - 3	4 %
5 - H 2 B (F) - F	4 %
7 - H B (F, F) - F	6 %
5 - H B - C L	4 %
3 - H H B (F, F) - F	10 %
5 - H H B (F, F) - F	5 %

3 - H H B (F) - O C F 2 H	5 %
3 - H H B (F) - O C F 3	10 %
3 - H H B (F, F) - O C F 3	6 %
3 - G H B (F, F) - F	8 %
3 - H G B - F	5 %
3 - H H X B (F, F) - F	6 %
5 - H H X B (F, F) - F	5 %
3 - H 2 H X B (F, F) - F	5 %
3 - H H - 4	5 %
3 - H B - O 2	5 %
3 - H H E B H - 3	3 %

N I = 79. 8°C ; T<sub>C</sub> < -20°C ; Δ n = 0. 069 ; η = 24. 0 mPa  
 · s ; V<sub>t h</sub> = 1. 28V ; V<sub>H R - 1</sub> = 98. 5% ; V<sub>H R - 2</sub> = 84. 9%

## 【0070】

## 比較例 3

特開平10-204436号公報に開示された組成物の中から実施例4を選んだ。理由は、この組成物が本発明の化合物(3)を含有し、そして最も小さい光学異方性を有するからである。この組成物の成分および特性は下記のとおりである。この組成物において、上限温度は低く、下限温度は高く、光学異方性は大きく、そしてV<sub>H R - 2</sub>は小さい。

3 - H H X B (F) - F	2 %
3 - H 2 H X B (F) - F	2 %
3 - H 2 H X B (F) - O C F 3	2 %
2 - H H X B (F, F) - F	5 %
3 - H H X B (F, F) - F	5 %
4 - H H X B (F, F) - F	5 %
5 - H H X B (F, F) - F	5 %
7 - H B (F, F) - F	9 %

3 - H <sub>2</sub> HB (F, F) - F	6 %
3 - HHB (F, F) - F	10 %
4 - HHB (F, F) - F	5 %
3 - HH <sub>2</sub> B (F, F) - F	7 %
3 - HBB (F, F) - F	15 %
5 - HEB (F, F) - F	6 %
2 - HHB (F, F) XB (F, F) - F	4 %
3 - HHB (F, F) XB (F, F) - F	4 %
4 - HHB (F, F) XB (F, F) - F	4 %
5 - HHB (F, F) XB (F, F) - F	4 %
N I = 71. 2°C ; T <sub>C</sub> < -10°C ; Δn = 0.080 ; η = 26.2 MPa · s ; Vth = 1.45V ; VHR-1 = 98.6% ; VHR-2 = 86.2%	

## 【0071】

## 比較例4

特開平10-204016号公報に開示された組成物の中から使用例19を選んだ。理由は、この組成物が本発明の化合物(7)を含有し、そして最も小さい光学異方性を有するからである。この組成物の成分および特性は下記のとおりである。この組成物において、下限温度は高く、光学異方性は大きく、そしてしきい値電圧は大きい。

5 - HXB (F, F) - F	2 %
5 - HXB (F, F) - OCF <sub>3</sub>	2 %
5 - HXB (F, F) - C <sub>2</sub> F <sub>5</sub>	2 %
5 - HXB (F, F) - OCF <sub>2</sub> H	2 %
5 - HB - F	12 %
6 - HB - F	8 %
2 - HHB - OCF <sub>3</sub>	7 %
3 - HHB - OCF <sub>3</sub>	7 %
4 - HHB - OCF <sub>3</sub>	7 %

5 - H H B - O C F 3	5 %
3 - H H 2 B - O C F 3	4 %
5 - H H 2 B - O C F 3	4 %
3 - H H B (F, F) - O C F 3	5 %
3 - H B B (F) - F	1 0 %
5 - H B B (F) - F	1 0 %
3 - H H 2 B (F) - F	3 %
3 - H B (F) B H - 3	3 %
5 - H B B H - 3	3 %
3 - H H B (F, F) - O C F 2 H	4 %

N I = 82. 6°C ; T<sub>C</sub> < -10°C ; Δn = 0. 090 ; η = 18. 1 mPa  
 · s ; V t h = 2. 12 ; V H R - 1 = 98. 1 % ; V H R - 2 = 93. 2 %.

## 【0072】

## 実施例 1

2 - H H B (F) - F	(1 - 1)	6 %
3 - H H B (F) - F	(1 - 1)	1 0 %
5 - H H B (F) - F	(1 - 1)	6 %
2 - H 2 H B (F) - F	(1 - 2)	5 %
3 - H 2 H B (F) - F	(1 - 2)	7 %
3 - H H - 4	(4 - 1)	5 %
5 - H H - V	(4 - 1)	2 0 %
3 - H H E B - F	(5 - 1)	7 %
5 - H H E B - F	(5 - 1)	7 %
3 - H H E B H - 3	(5 - 3)	5 %
3 - H H E B H - 4	(5 - 3)	5 %
5 - H X B (F, F) - F	(7 - 1)	1 2 %
7 - H X B (F, F) - F	(7 - 1)	5 %

N I = 90. 5°C ; T<sub>C</sub> < -30°C ; Δn = 0. 067 ; η = 18. 0 mPa  
 · s ; V t h = 1. 73V ; V H R - 1 = 98. 9 % ; V H R - 2 = 93. 8 %

## 【0073】

## 実施例2

2 - H H B (F) - F	(1 - 1)	7 %
3 - H H B (F) - F	(1 - 1)	1 5 %
5 - H H B (F) - F	(1 - 1)	7 %
2 - H H 2 B (F) - F	(1 - 3)	2 %
5 - H H - V	(4 - 1)	2 0 %
3 - H H E B - F	(5 - 1)	5 %
5 - H H E B - F	(5 - 1)	5 %
3 - H H E B H - 3	(5 - 3)	5 %
3 - H H E B H - 4	(5 - 3)	5 %
3 - H H E B H - 5	(5 - 3)	4 %
5 - H X B (F, F) - F	(7 - 1)	1 2 %
7 - H X B (F, F) - F	(7 - 1)	5 %
5 - H X B (F) - F	(7 - 2)	4 %
5 - H X B (F) - O C F 3	(7 - 3)	4 %

N I = 8 6. 8 °C ; T<sub>C</sub> < - 3 0 °C ; Δ n = 0. 0 6 9 ; η = 1 7. 7 mPa  
 · s ; V t h = 1. 8 3 V ; V H R - 1 = 9 8. 3 % ; V H R - 2 = 9 3. 1 %

## 【0074】

## 実施例3

V - H H B (F) - F	(1 - 1)	7 %
3 - H H B (F) - F	(1 - 1)	1 4 %
5 - H H B (F) - F	(1 - 1)	7 %
2 - H 2 H B (F) - F	(1 - 2)	5 %
3 - H 2 H B (F) - F	(1 - 2)	5 %
5 - H H - V	(4 - 1)	2 0 %
5 - H H - O 1	(4 - 2)	4 %

5 - H H - C F 3	(4 - 4)	2 %
3 - H H E H - 3	(5 - 2)	5 %
3 - H H E H - 4	(5 - 2)	5 %
3 - H H E B H - 3	(5 - 3)	5 %
3 - H H E B H - 4	(5 - 3)	5 %
5 - H X B (F, F) - F	(7 - 1)	8 %
5 - H X B (F) - O C F 3	(7 - 3)	8 %
N I = 9 0 . 7 °C ; T C < - 3 0 °C ; Δ n = 0 . 0 6 8 ; η = 1 8 . 8 m P a · s ; V t h = 1 . 7 4 V ; V H R - 1 = 9 8 . 8 % ; V H R - 2 = 9 3 . 5 %		

## 【0075】

## 実施例4

2 - H H B (F) - F	(1 - 1)	5 %
3 - H H B (F) - F	(1 - 1)	1 0 %
5 - H H B (F) - F	(1 - 1)	5 %
2 - H 2 H B (F) - F	(1 - 2)	6 %
3 - H 2 H B (F) - F	(1 - 2)	6 %
2 - H H B (F, F) - F	(2 - 1)	5 %
3 - H H B (F, F) - F	(2 - 1)	1 0 %
3 - H 2 H B (F, F) - F	(2 - 2)	3 %
3 - H H 2 B (F, F) - F	(2 - 3)	2 %
3 - H H - 4	(4 - 1)	3 %
5 - H H - V	(4 - 1)	8 %
5 - H H - V F F	(4 - 3)	3 %
3 - H H E B H - 3	(5 - 3)	5 %
3 - H H E B H - 4	(5 - 3)	5 %
3 - H H B (F) - O C F 3	(6 - 1)	2 %
2 - H H X B (F) - O C F 3	(6 - 2)	3 %
3 - H H X B (F) - O C F 3	(6 - 2)	4 %

5-HHXB (F) -OCF3	(6-2)	4%
5-HXB (F, F) -F	(7-1)	7%
5-HXB (F) -OCF3	(7-3)	4%
$N_I = 90.3^\circ\text{C}$ ; $T_C < -30^\circ\text{C}$ ; $\Delta n = 0.074$ ; $\eta = 23.8 \text{ mPa s}$ ; $Vth = 1.47 \text{ V}$ ; $VHR-1 = 98.6\%$ ; $VHR-2 = 93.3\%$		

## 【0076】

## 実施例5

3-HHB (F) -F	(1-1)	10%
V-HHB (F) -F	(1-1)	11%
2-H2HB (F) -F	(1-2)	10%
3-H2HB (F) -F	(1-2)	8%
5-H2HB (F) -F	(1-2)	5%
2-HHB (F, F) -F	(2-1)	5%
3-HHB (F, F) -F	(2-1)	5%
2-HHXB (F, F) -F	(3-1)	5%
3-HHXB (F, F) -F	(3-1)	8%
4-HHXB (F, F) -F	(3-1)	2%
3-HHXB (F) -F	(3-2)	2%
3-HH-4	(4-1)	5%
3-HHEBH-3	(5-3)	4%
3-HHEBH-4	(5-3)	4%
5-HXB (F, F) -F	(7-1)	9%
7-HXB (F, F) -F	(7-1)	5%
1O1-HH-3	(-)	2%

$N_I = 86.7^\circ\text{C}$ ;  $T_C < -30^\circ\text{C}$ ;  $\Delta n = 0.074$ ;  $\eta = 22.5 \text{ mPa s}$ ;  $Vth = 1.36 \text{ V}$ ;  $VHR-1 = 98.3\%$ ;  $VHR-2 = 93.2\%$

## 【0077】

## 実施例6

V - H H B (F) - F	(1 - 1)	3 %
2 - H H B (F) - F	(1 - 1)	5 %
2 - H H B (F, F) - F	(2 - 1)	10 %
3 - H H B (F, F) - F	(2 - 1)	10 %
2 - H H X B (F, F) - F	(3 - 1)	4 %
3 - H H X B (F, F) - F	(3 - 1)	10 %
4 - H H X B (F, F) - F	(3 - 1)	5 %
5 - H H X B (F, F) - F	(3 - 1)	7 %
2 - H H X B (F) - F	(3 - 2)	5 %
3 - H H X B (F) - F	(3 - 2)	5 %
3 - H H - 4	(4 - 1)	5 %
5 - H H - V	(4 - 1)	25 %
3 - H H E H - 3	(5 - 2)	3 %
3 - H H E H - 4	(5 - 2)	3 %
N I = 85. 2 °C ; T <sub>C</sub> < -30 °C ; Δ n = 0. 070 ; η = 19. 4 mPa · s ; V th = 1. 49 V ; VHR - 1 = 98. 5 % ; VHR - 2 = 93. 1 %		

【0078】

## 実施例7

3 - H H B (F) - F	(1 - 1)	10 %
2 - H 2 H B (F) - F	(1 - 2)	8 %
2 - H H 2 B (F) - F	(1 - 3)	3 %
2 - H H B (F, F) - F	(2 - 1)	9 %
3 - H H B (F, F) - F	(2 - 1)	9 %
3 - H 2 H B (F, F) - F	(2 - 2)	12 %
5 - H 2 H B (F, F) - F	(2 - 2)	12 %
3 - H H 2 B (F, F) - F	(2 - 3)	3 %
2 - H H X B (F, F) - F	(3 - 1)	5 %

3-HHXB (F, F) - F	(3-1)	8 %
3-HH-4	(4-1)	5 %
5-HH-V	(4-1)	10 %
3-HHEBH-3	(5-3)	3 %
3-HHEBH-4	(5-3)	3 %
N I = 86. 1°C ; T <sub>C</sub> < -30°C ; Δn = 0.072 ; η = 22.1 mPa · s ; Vth = 1.29V ; VHR-1 = 98.9% ; VHR-2 = 93.4%		

## 【0079】

## 実施例8

2-HHB (F) - F	(1-1)	4 %
2-H2HB (F) - F	(1-2)	3 %
2-HHB (F, F) - F	(2-1)	6 %
3-HHB (F, F) - F	(2-1)	10 %
4-HHB (F, F) - F	(2-1)	3 %
3-H2HB (F, F) - F	(2-2)	12 %
4-H2HB (F, F) - F	(2-2)	8 %
5-H2HB (F, F) - F	(2-2)	12 %
2-HHXB (F, F) - F	(3-1)	5 %
3-HHXB (F, F) - F	(3-1)	8 %
3-HH-4	(4-1)	3 %
5-HH-V	(4-1)	6 %
5-HH-O1	(4-2)	3 %
5-HH-VFF	(4-3)	3 %
5-HH-CF3	(4-4)	2 %
3-HHEB-F	(5-1)	4 %
5-HHEB-F	(5-1)	3 %
3-HHEBH-3	(5-3)	5 %

N I = 85. 3°C ; T<sub>C</sub> < -30°C ; Δn = 0.070 ; η = 22.3 mPa

• s ; V<sub>t h</sub> = 1. 32 V ; VHR-1 = 98. 7 % ; VHR-2 = 93. 1 %

## 【0080】

## 実施例9

3-HHB (F) - F	(1-1)	4 %
2-HHB (F, F) - F	(2-1)	5 %
3-HHB (F, F) - F	(2-1)	10 %
2-H2HB (F, F) - F	(2-2)	5 %
3-H2HB (F, F) - F	(2-2)	12 %
2-HHXB (F, F) - F	(3-1)	5 %
3-HHXB (F, F) - F	(3-1)	11 %
5-HHXB (F, F) - F	(3-1)	5 %
3-HHXB (F) - F	(3-2)	7 %
3-HH-4	(4-1)	6 %
5-HH-V	(4-1)	10 %
3-HHEB-F	(5-1)	6 %
3-HHEBH-3	(5-3)	4 %
3-HHB (F) - OCF3	(6-1)	3 %
2-HHXB (F) - OCF3	(6-2)	3 %
3-HHXB (F) - OCF3	(6-2)	4 %

N I = 90. 6 °C ; T<sub>C</sub> < -30 °C ; Δ n = 0. 074 ; η = 23. 1 mPa

• s ; V<sub>t h</sub> = 1. 33 V ; VHR-1 = 98. 9 % ; VHR-2 = 93. 3 %

## 【0081】

## 実施例10

2-HHB (F) - F	(1-1)	4 %
3-HHB (F) - F	(1-1)	8 %
2-HHB (F, F) - F	(2-1)	8 %
3-HHB (F, F) - F	(2-1)	8 %

3 - H2HB (F, F) - F	(2 - 2)	1 2 %
2 - HHXB (F, F) - F	(3 - 1)	5 %
3 - HHXB (F, F) - F	(3 - 1)	5 %
5 - HHXB (F, F) - F	(3 - 1)	5 %
3 - HHXB (F) - F	(3 - 2)	3 %
3 - HH - 4	(4 - 1)	5 %
5 - HH - V	(4 - 1)	1 8 %
3 - HHEBH - 3	(5 - 3)	3 %
3 - HHEBH - 4	(5 - 3)	2 %
3 - HHEBH - 5	(5 - 3)	2 %
3 - HHB (F) - OCF3	(6 - 1)	3 %
3 - HHXB (F) - OCF3	(6 - 2)	7 %
101 - HH - 3	(-)	2 %

N I = 91. 9 °C ; T<sub>C</sub> < -30 °C ; Δ n = 0. 071 ; η = 20. 3 MPa  
 s ; V<sub>t h</sub> = 1. 48 V ; VHR - 1 = 98. 6 % ; VHR - 2 = 93. 9 %

## 【0082】

## 【発明の効果】

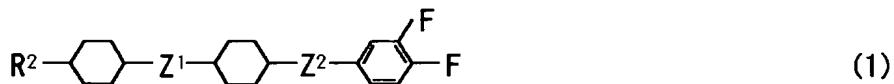
本発明の組成物は、ネマチック相の広い温度範囲、小さな粘度、小さな光学異方性、低いしきい値電圧、および大きな比抵抗などの特性において、複数の特性を充足する。この組成物は、複数の特性に関して適切なバランスを有する。この組成物を含有する素子は、特に大きな電圧保持率を有する。この組成物は、主として0. 06~0. 075の光学異方性を有するので、反射型または半透過型のAM素子に特に適する。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明の課題は、ネマチック相の広い温度範囲、小さな粘度、小さな光学異方性、低いしきい値電圧、および大きな比抵抗などの特性において、複数の特性を充足する液晶組成物を提供することにある。この課題は複数の特性に関して適切なバランスを有する液晶組成物を提供することでもある。この課題は、この組成物を含有し、そして特に大きな電圧保持率を有する液晶表示素子を提供することでもある。

【解決の手段】 化合物(1)から選択された少なくとも1つの化合物とその他の成分を含有する液晶組成物、およびこの組成物を含有するAM素子。



$\text{R}^2$ はアルキルまたはアルケニルであり、 $\text{Z}^1$ および $\text{Z}^2$ は独立して単結合または $-(\text{CH}_2)_2-$ である。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-352263
受付番号	50201835576
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0095
作成日	平成14年12月10日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】	申請人
【識別番号】	000002071
【住所又は居所】	大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号
【氏名又は名称】	チッソ株式会社
【特許出願人】	
【識別番号】	596032100
【住所又は居所】	東京都中央区勝どき三丁目13番1号
【氏名又は名称】	チッソ石油化学株式会社

次頁無

出願人履歴情報

識別番号 [000002071]

1. 変更年月日 1990年 8月23日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号

氏 名 チッソ株式会社

出願人履歴情報

識別番号 [596032100]

1. 変更年月日 2002年 7月 1日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都中央区勝どき三丁目13番1号  
氏 名 チッソ石油化学株式会社